# 気相成長によるシリコン結晶について

近	藤	正	男
中	谷	訓	幸

## On Silicon Crystals Grown from the Vapor

Masao KONDO Noriyuki NAKATANI

The structure of silicon crystals grown from the carrier gas (argon) with SiCl<sub>4</sub> reacting with Zn below 900°C, has been studied with the 120KV electron microscope. With this apparatus the diffraction pattern and micrographs can be obtained. The form of crystals is fibrous with rough-edges, needles or ribbons growing in <211> direction, the surfaces of which are {111}. Along the growing direction, we recognized the dislocation.

SiCl₄蒸気を含だキャリャガス(アルゴン)を900℃以下でZnによって還元して得られたシリコン結晶の構造を120KV電子顕微鏡を用いて研究した。この装置で電子線回折像と拡大像とを得た。結晶の形は、表面粗な繊維状のものや針状のもの、{111} 面から成り<211>方向に成長しているリボン状のものであった。成長方向にdislocationが認められた。

#### 1. 緒 1

珪素はそのハロゲン化物の熱分解,水素又はZn等の 金属による還元によってその結晶を生ずる。Znガスに よってSiCl4が還元されてSi 結晶を生ずる反応は Du Pont法としてよく知られているが,Znガスが他の不活 性ガスによってうすめられるとSiは繊維状に生ずる。 E.R. Johnsonと J.A.Amick はこの方法で表面の凹凸 のはげしい whisker を得て,それが<111>方向にの びていることを報告している。<sup>(1)</sup>又R.S.Wanger らは SiI2の熱分解によって3種の形状の結晶を得ている。 それは(1)多くの双晶を含む塊状又はフィルム状の多結 晶体,(2)ミクロンサイズの<111>にのびた針状結晶, (3){111}の双晶面をもち<211>方向にのびたリボン状 結晶,であった。前者はScrew dislocationによって成 長するメカニズムを考えているがそのdislocationを確 認できなかったし,後者は不純物がSiの融点を下げ, その飽和溶液から液一固境界に次々にSiが折出して 成長するメカニズムを考えた。現在繊維状結晶\*の成 長機構はその他にM.VolmerとA.Weber(1925),W. Kossel (1930), R.BeckerとW.Döring(1935)の提唱 するような「完全結晶表面上に階段を持った新らしい 原子層が次々に核形成をしながら成長する2次元核形 成理論」がある上。記のようなScrew dislocationによ る成長理論を考えている場合の一番の難点は,その転



位を実験的に検出した例が少いということである。こ れは Screw dislocationによって成長が始まっても、結 晶が成長している間に転位が上昇運動等によって移動 して外部へ出てしまうのにはないかと考えられる。よ って筆者等は低温短時間で織維状結晶を生成させ、そ の転位その他を電子顕微鏡でしらべた。 試料は SiCl<sub>4</sub> をZnによって還元する方法を用いたが、その結果E.



(a) 900°C 15min



(b) 800°C



(c) 700°C 図-2

R.Johnson 等の得た表面凹凸のはげしい whisker の 他に外部が単純に見えるリボン状又は針状の結晶を得 た。これらは R.S.Wagner 等の得たものと形状は 似ているが多くの点で異るので、これらを電子顕微鏡 でしらべた結果を簡単に報告する。

## 2. Si 結晶の作製

本研究に使用した方法は、SiCl4 を含んだアルゴン



(a) 900°C 15min



(b) 800°C



(c) 700°C 1 h 図— 3

を、加熱した粒状亜鉛上に流してSiCl<sub>4</sub>をZnで還元し てSi結晶を炉内に生じさせる方法であって、E.R. Johnson 等が800~1,000℃での実験を行っているが, 本研究の目的に沿うてその下限における実験として特 に900℃以下を選んだ。アルゴン流量は0.1~0.4ℓ/ min,加熱炉は内径22mm長さ600mmの耐火磁性管状 炉(均一加熱部は約150mm)を用いた。(図-1)





図-5 (図-4)の部分の diffraction pattern



図-6 ×5000



図-7



図-8 ×2500



図—9 ×1800





アルゴン流量2 $\ell$ /minで試験温度になるまで流し、 その温度でSiCl<sub>4</sub>を加えた。図-2はSiの代表的な生 成状態を示している。700℃よりも低くなると結晶の 生成は認められないが図―2(c)のように700℃でも whisker状のSi がかなり明瞭に認められる。 更に代表 的な結晶を図-3に示した。図-3(a)に示したもの



図—11  $\times 3000$ 



 $(\boxtimes -11) \mathcal{O}$ extinction 図—12 contourの中心部でのdiffraction pattern



図-13  $\times 3000$ 

はかなり扁平に近いものであるが表面に凹凸が見られ る。図-3(c)のものは不定形のねじれた繊維状で, 図-3(b)はその両方が混在していて光線のぐあいに よって扁平なものも暗く見えている。リボン状のもの で巾100µ以下長さ0.5mm以下,その他の繊維状のも ので太さ50µ以下長さ2mm以下であった。SiCl<sub>4</sub>は最



×16000



(図14一)の部分 図-15 diffraction pattern

高温度に違したときに流し始めて, 還元作用は一様な 温度降下時に行なわれるようにし,温度の上下変動に よる不規則な現象の起らないようにした。

#### 電子顕微鏡による観察

細いリボン状の結晶、その他の繊維状の結晶、それ に形状の不規則な結晶の集合の電子顕微鏡写真を図一 4に示した。この部分の diffraction pattern は図-5 で、いずれのSpotもSiの回折線を示している。このこ とからこれらの微結晶がいずれも Si であることがわ かる。図-6~図-10にリボン状のSiの代表的なもの を示した。 結晶内部に見える明暗のコントラストは bending による干渉編である。リボン状の Si の多く のものはリボンの中心で干渉縞の不連続があらわれる

が、これは dislocation によるコントラストである。

図—11の結晶内部に見える幾何学的な模様は試料の bendingによるextincton contourであり、この部分で は結晶の6 回対称軸に平行に電子線が入射しているこ とを示している。図—12がこの部分における diffraction patternで、これは正確にSiの(111)逆格子面 に対応している。これよりリボンの扁平な面は(111) 面で、その成長方向は <211> であることがわかる。 extinction contourの編の間隔より計算すると結晶の 厚さは約500Åで、極めて薄いことがわかる。

図-13にはリボン状の Si と針状の Si とが w られる が、リボン状の方は巾が10 µ 以上もあるが、 厚さは電 子線が透過するほど薄くて、 bending による干渉 縞が 見られる。針状の方は太さが 3,000 Å程度である。

リボンの鋸状の側面もその角度から推定すると {111} 面で形成されているものと考えられるが,結晶 がいずれも極めて薄くて側面の形状を直接観察するこ とができなかった。また明確な等厚干渉縞も得ること ができなかった。なお図-9,図-10にはリボンの端 や内部に結晶成長がさらに進行して厚さの異る部分が あるが,(これは光学顕微鏡によっても反射光あるい は透過光の色の差として観察できる。)この部分の側 面も{111}面より成るものと考えられる。

図-14は700℃での作製で得られた扁平な試料である。端の部分に若干の規則性は認められるが表面は平 坦ではない。この部分のdiffraction patternを図-15 に示す。この回折リングは相当に diffuse しているこ とから試料は非常にこまかい結晶の集合であることが わかるが、このリングは Si あるいは Si の酸化物には 対応していない。

#### 4. 考察

(a) 図一1に示すボート中に置いたZnは化学用純 の粒状で,ボートの中央よりもガス入口に近い方にあ り,アルゴンに含有されたSiCl4は気化したZnによって 還元されてそのボートのガス出口寄りに Si を析出す る。700℃よりも低い温度では,Znは単に溶融するの みで温度を下げて室温に至って殆んど変化していな い。したがってSi の析出も殆んど無いが,700℃では 図一2(c)のように扁平なリボン状又は針状のSi が互 にからみ合って生じている。一定条件では温度が高い 程繊維は長くなり数も多くなる。又処理時間の長い程 その量が多くなるが今回その関係は定量的にははから なかった。900℃では繊維は太くなり,120KV電子顕 微鏡で電子ビームを透過しないものが多かった。今回 は透過しないものは外形のみを観察するに止めたが, 図 $-6\sim$ 図-8のように扁平で凹凸のないものも多かった。又表面凹凸の多いもの,又何か附着しているように見えるものは肉眼で黒みを帯びて見えた。Zn又は $ZnCl_2$ が附着していると言われているが確認できなかった。

b) 扁平な結晶について、その表面には図-9に見 えるようにヘリに他の結晶が附着しているように見 え、又図-10のように中央に附着しているように見え るものもあったがいずれも母体と同一の原子配列であ って、結晶が成長して出来たものと思われる。表面平 滑な結晶について extinction contourによって厚みを 計算したものは500Å, 700Åであった。

c) リボン状の結晶の扁平な面は(111)であるが, その中央部結晶の成長した方向に図−6~図−8に 見るように,コントラストが見られる。その方向は <211>であるが, R.S.Wagner等の研究<sup>(2)</sup>による と,(111)が双晶の境界面になっている。本研究で はこのような双晶の境界面は認められなかった。又図 −8に見るように電子ビームが垂直に通る部分の近傍 のみこのコントラストが認められた。これらの点から してこれは screw dislocation であろうと思われる。

b) 上記の(111)表面を境する結晶面はマクロ的には直線に見えるものが多いが、ミクロ的には鋸歯状になって互に交針した2面から成っている。(111) 面となす角度から推定するとこれらの面も{111}面と思われる。成長する先端の面も同様と見てよい。この点はR.S.WagnerのX線回折による結果と一致している。

e) 溶液からの引上法によって成長させたSi結晶は 扁平な(111)面を持ち.鋸歯状の面で境されていて, 結晶成長方向は<211>であるが<sup>(3)</sup>,本研究で得たリ ボン状結晶に対応している。

f) 繊維状結晶の成長に対して不純物は影響がある がZnは成長を促進しない。R.S.Wagner等はZnの存 在によって繊維状結晶を得ていない。本研究で使用し たSiCl4 は化学用純であるが, SiCl4】の不純物を除去 することはかなり困難であるから,その点では不純物 の影響が無いとは言えない。

g) 試料にはbend extinction contoursが認められ た。図-11はその一例である。結晶の彎曲状態はこの 図形を解析することによって明らかとなるが、これに 関する報告及び考察は他に譲りたい。

## 5. 結 論

常温で気化したSiCl4 を含有するアルゴンを加熱炉 に導入し、炉中に置いたZnによって還元させて得た Si結晶について、その結晶状態を電子顕微鏡でしらべた。

- (1) 繊維状の結晶は700℃以上の温度で得られる。
- (2) リボン状の結晶は(111)面が広く、その面の ヘリや中央に結晶の厚みを増した状態が見られた。
- (3) リボン状結晶の長手方向は <211> であるが
  (111)面から見ると(111)面のほぼ中央に<211>
  方向に dislocation が見られる。
- (4) (111) 面を境する面は鋸歯状で{111}から成る と見てよい。
- (5) 双晶は認められなかった。
- 文 献

.

- E. R. Johnson and J. A. Amick : J. appl. phys. 25 (1954) 1204
- 2) R. S. Wagner et al: J. appl. Phys. 35 (1964) 2993
- J. W. Faust Jr. and H. F. John : J .Phys.Chem. Solids 25 (1964) 1407
- ※繊維状結晶又はWhiskerはリボン状,針状の結晶その他細長い結 晶の総称である。